

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织  
国际局



(43) 国际公布日:  
2005年10月13日(13.10.2005)

PCT

(10) 国际公布号:  
WO 2005/096312 A1

(51) 国际分类号<sup>7</sup>: G11C 11/14, H01L 27/00  
(21) 国际申请号: PCT/CN2004/001385  
(22) 国际申请日: 2004年12月1日(01.12.2004)  
(25) 申请语言: 中文  
(26) 公布语言: 中文  
(30) 优先权:  
200410030729.X 2004年4月1日(01.04.2004) CN  
(71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 中国科学院物理研究所(INSTITUTE OF PHYSICS, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES) [CN/CN]; 中国北京市海淀区中关村南三街8号, Beijing 100080 (CN).  
(72) 发明人;及  
(75) 发明人/申请人(仅对美国): 彭子龙(PENG, Zilong) [CN/CN]; 韩秀峰(HAN, Xiufeng) [CN/CN]; 赵素芬(ZHAO, Sufen) [CN/CN]; 王伟宁(WANG, Weineng) [CN/CN]; 詹文山(ZHAN, Wenshan) [CN/CN]; 中国北京市海淀区中关村南三街8号, Beijing 100080 (CN).  
(74) 代理人: 北京市柳沈律师事务所(LIU, SHEN & ASSOCIATES); 中国北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦A0601, Beijing 100101 (CN).

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW  
(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

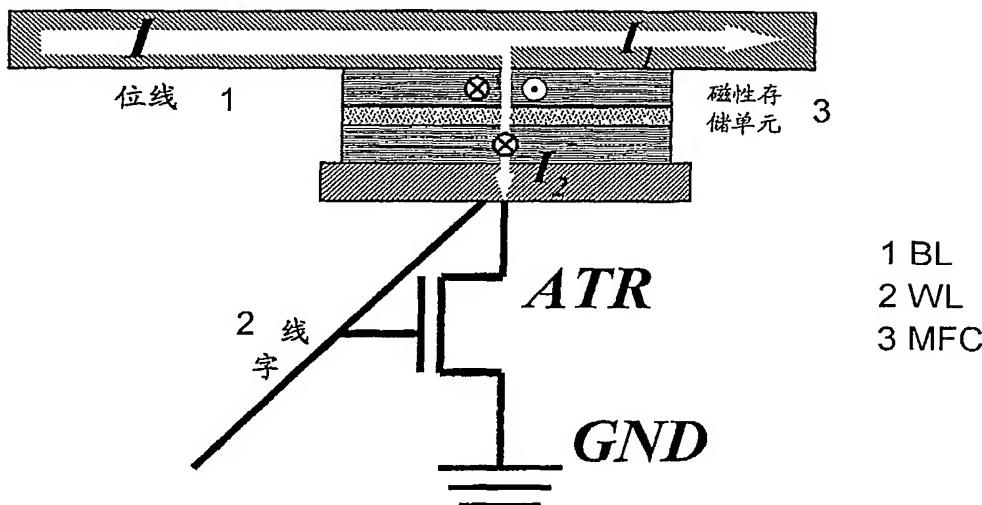
本国际公布:

— 包括国际检索报告。

所引用双字母代码和其它缩写符号, 请参考刊登在每期PCT公报期刊起始的“代码及缩写符号简要说明”。

(54) Title: MRAM BASED ON VERTICAL CURRENT WRITING AND ITS CONTROL METHOD

(54) 发明名称: 一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器及其控制方法



1 BL  
2 WL  
3 MFC

WO 2005/096312 A1

(57) Abstract: The invention discloses a MRAM (Magnetoresistive RAM) based on vertical current writing and its control method, the operation of information writing in the MRAM unit is completed by the corporate effect of the magnetic field generated by the current parallel to the MFC unit and the other current vertical to the MFC unit and passing through this unit. The advantage of such structure is: eliminating a word line (WL) of the current art especially for information writing, reducing the number of metal wiring layers and the contact holes, reducing the complexity of MRAM's structure, difficulty and cost of manufacturing process.

[见续页]



---

(57) 摘要

本发明公开了一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器及其控制方法，该 MRAM 单元中的信息写入操作由一个平行于磁性薄膜存储单元 MFC 的电流以及另一个垂直于磁性薄膜存储单元 MFC 并流经该单元的电流所产生的磁场的共同作用来完成。这种结构的优点在于，取消了现有技术中专门用于信息写入的一条字线，减少了金属布线层以及接触孔的数目，降低了 MRAM 结构的复杂性、制造工艺的难度及其成本。

# 一种基于垂直电流写入的磁随机存取 存储器及其控制方法

## 技术领域

5 由最近发展起来的磁电阻效应多层薄膜可构成随机存取存储器(RAM, Random Access Memory)中的记忆单元, 这种 RAM 即是所谓的磁电阻随机存取存储器 (Magnetoresistive RAM), 简称 MRAM。本发明所涉及的是实现 MRAM 中信息写入的一种新方法。

## 10 背景技术

### 一、MRAM 中的磁性薄膜存储单元 MFC (Magnetic Film Cell)

作为 MRAM 的存储单元, 磁性薄膜中至少包含这样的一个薄膜机构: [F1/NF/F2]。其中 F1 和 F2 表示两个磁性材料层, NF 表示非磁性材料层, NF 层介于 F1 层和 F2 层之间。F1 和 F2 中有且仅有一层的磁化方向被外界某层或数层的材料所固定 (称为被钉扎层), 因而不能在小的外磁场作用下随意变化; 而另外一层为软磁层, 其磁化方向可在小的外磁场作用下发生变化 (称为自由层)。非磁性材料层的厚度很小, 典型的厚度在 0.5nm 与 3.0nm 之间。以这样的磁性薄膜作为存储单元, 当 F1、F2 的磁化方向相同时, 磁性薄膜存储单元 MFC 表现出低的电阻状态; 而当 F1、F2 的磁化方向相反时, 磁性薄膜存储单元 MFC 则表现出高的电阻状态。

因此, 磁性薄膜存储单元 MFC 存在着两个稳定的电阻状态, 通过改变磁性薄膜存储单元 MFC 中自由层相对于被钉扎层的磁化方向, 即可使之记录信息; 而通过检测磁性薄膜存储单元 MFC 的电阻状态, 即可获取其保存的信息。

### 二、典型的 MRAM 单元结构

目前通常采用的磁性薄膜存储单元 MFC 的结构如图 1 所示。该 MRAM 结构配置在半导体衬底上, 共需要三个金属布线层 M1、M2、M3 和一个过渡金属层 TM。除了读字线 RWL, 其地线 GND、写字线 WWL 和位线 BL 分别处于不同的金属布线层中。磁性薄膜存储单元 MFC 通过过渡金属层 TM、金属布线层 M2、M1 以及相关接触孔与晶体管 ATR 的漏区相连接, 而晶体管 ATR 的源区则和地线 GND 连接, 晶体管 ATR 的栅极同时也是读字线 RWL。

磁性薄膜存储单元 MFC 中信息的写入由位线 BL 和写字线 WWL 来协同

完成。当位线 BL 和写字线 WWL 以一定的时序关系通过写入工作电流时，两者的电流所产生的磁场的合成磁场将使磁性薄膜存储单元 MFC 中自由层的磁化方向翻转到特定的方向，该磁化方向在撤销位线 BL、写字线 WWL 的电流之后能够稳定在其两个稳定状态中被期望的一个状态。由此即实现了磁性薄膜存储单元 MFC 中信息的写入并保存。

读取磁性薄膜存储单元 MFC 中的信息则由读字线 RWL 来控制。在允许读取时，控制读字线 RWL 在一个合适的电平上，使得晶体管 ATR 导通。此时存在一个由位线 BL（金属布线层 M3）经磁性薄膜存储单元 MFC、过渡金属层 TM、接触孔、金属布线层 M2、接触孔、金属布线层 M1、接触孔、晶体管 ATR 漏区、晶体管 ATR 源区而至地线 GND 的电气通路。因此，由位线 BL 给一个合适的读电流，即可提取磁性薄膜存储单元 MFC 当前的电阻状态。由此即实现了磁性薄膜存储单元 MFC 中信息的读出。

如上所述，该种结构的 MRAM 需要多达三个的金属布线层以及一个过渡金属层来形成其电气连接，使得 MRAM 的制造工艺复杂、成本高。另外，在制造磁性薄膜存储单元 MFC 之前，衬底上已经经过了数次的沉积、布线、打孔、绝缘介质填埋等工艺操作，使得磁性薄膜存储单元 MFC 制造面的表面平整性较差，必须进行特殊的表面抛平工艺处理（比如化学机械抛光 CMP，Chemical-Mechanical Polishing）才能满足磁性薄膜存储薄膜对其衬底表面平整性的特殊要求，这也是一个增加工艺难度和制造成本的问题。

20

### 发明内容

为了解决上述的技术问题，本发明的目的是提供一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器的控制方法；本发明进一步地还提供基于本发明控制方法的存取存储器。

为达到上述目的，本发明一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器的控制方法具体为：磁随机存取存储器磁性薄膜存储单元 MFC 中的信息写入操作由一个平行于磁性薄膜存储单元 MFC 的电流以及另一个垂直于磁性薄膜存储单元 MFC、并流经该单元的电流所产生的磁场的共同作用来完成。

实现上述磁随机存取存储器的控制方法的一种磁随机存取存储器，包括：晶体管 ATR 单元构成的存储器读写控制单元阵列，该读写控制单元阵列集成在半导体衬底中；磁性薄膜存储单元 MFC 构成的存储单元阵列；过渡金属层，

所述磁性薄膜存储单元 MFC 经由该过渡金属层和所述晶体管 ATR 单元相连接；以及字线 WL (Word Line) 和位线 BL(Bit Line)，所述字线 WL 同时也是所述晶体管 ATR 的栅极，所述位线 BL 布置在所述磁性薄膜存储单元 MFC 的上方，与所述字线 WL 相互垂直，与所述磁性薄膜存储单元 MFC 直接相连，  
5 并且与磁性薄膜存储单元 MFC 的易磁化方向垂直。在 MRAM 阵列中的每一条所述位线 BL 上设置一个或几个限流机构，它的作用是限定其所在电流通路所能经过的最大电流。

实现上述磁随机存取存储器的控制方法的另一种磁随机存取存储器，包括：晶体管 ATR 单元构成的存储器读写控制单元阵列，该读写控制单元阵列集成在半导体衬底中；磁性薄膜存储单元 MFC 构成的存储单元阵列；过渡金属层，所述磁性薄膜存储单元 MFC 经由该过渡金属层和所述晶体管 ATR 单元相连接；以及字线 WL 和两条位线 BL1、BL2，所述字线 WL 同时也是所述晶体管 ATR 的栅极，所述两条位线 BL1、BL2 布置在所述磁性薄膜存储单元 MFC 的上方，位线 BL1 与所述字线 WL 相互垂直，并且与磁性薄膜存储  
10 单元 MFC 的易磁化方向垂直，位线 BL2 与所述磁性薄膜存储单元 MFC 直接相连，并且由一绝缘层与位线 BL1 相互隔离。  
15

实现上述磁随机存取存储器的控制方法的第三种磁随机存取存储器，包括：晶体管 ATR 单元构成的存储器读写控制单元阵列，该读写控制单元阵列集成在半导体衬底中；磁性薄膜存储单元 MFC 构成的存储单元阵列；接触孔与过渡金属层，所述磁性薄膜存储单元 MFC 经由该接触孔与过渡金属层和所述晶体管 ATR 单元相连接；以及两条字线 WL1、WL2 和位线 BL，所述字线 WL1 同时也是所述晶体管 ATR 的栅极，所述字线 WL2 与所述位线 BL 布置在所述磁性薄膜存储单元 MFC 的上方，所述位线 BL 与所述字线 WL2 相互垂直，并且与磁性薄膜存储单元 MFC 的易磁化方向垂直，字线 WL2 与所述  
20 磁性薄膜存储单元 MFC 直接连接，并且由一绝缘层与位线 BL 相互隔离。  
25

本发明通过采用新的垂直电流写入方法，取消了现有技术中专门用于信息写入的一条字线，减少了金属布线层以及接触孔的数目，大大降低了 MRAM 结构的复杂性、制造工艺的难度及其成本。

30

## 附图说明

图 1 是现有技术磁随机存取存储器 MRAM 单元结构的三维示意图；

图 2 是本发明采用垂直电流写入方式的磁随机存取存储器实施例 1 的 MRAM 单元结构示意图；

图 3 是本发明的实施例 1 的 MRAM 单元结构的第一剖视图；

图 4 是本发明的实施例 1 的 MRAM 单元结构附加位线电流限流机构的整体示意图；

图 5 是本发明中垂直写入电流与平行写入电流在磁性薄膜存储单元 MFC 处产生的空间磁场示意图；

图 6 是本发明采用垂直电流写入方式的磁随机存取存储器实施例 2 的 MRAM 单元结构示意图；

图 7 是本发明的实施例 1 的 MRAM 单元结构的第一剖视图；

图 8 是本发明采用垂直电流写入方式的磁随机存取存储器实施例 2 之变形例的 MRAM 单元结构示意图；

图 9 是本发明实施例 2 之变形例的 MRAM 单元结构的第一剖视图。

## 15 具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

### MRAM 中垂直电流写入方法：

现有技术的 MRAM 写入操作由两个平行于存储单元平面的电流来协调完成，其中一个电流与存储单元的易磁化轴平行，另一个与之垂直。在上述 20 两个电流产生的磁场中，处于存储单元难磁化轴方向上的磁场提供适当大小的翻转磁场的强度，而由易磁化轴方向上的磁场来实现对存储单元磁化矢量翻转方向的选择。本发明提供一种新的写入方法，在该方法中，由平行存储单元平面的一个电流产生的存储单元易磁化方向上的磁场来提供适当大小的翻转磁场的强度，而由垂直存储单元平面且流过存储单元的电流产生的存储 25 单元平面内的环形磁场来实现对磁化矢量翻转方向的选择。以下以具体的实施例来进一步阐述本发明所提供的新的写入方法。

### 实施例 1：

如图 2、图 3 所示，MRAM 存储器中的磁性薄膜存储单元 MFC 阵列由大量的 MRAM 单元 1 组合而成，在一个 MRAM 单元 1 中，包括一个磁性薄膜存储单元 MFC2、晶体管 ATR 4、过渡金属层 3b、接触孔 3e 与 3f 和一组布线，即：位线 BL 3a、字线 WL 3d 以及地线 GND 3c。磁性薄膜存储单元

MFC2 与晶体管 ATR 4 通过过渡金属层 3b 相互连接。在布局上将位线 BL 3a 布置在磁性薄膜存储单元 MFC2 的上方并且与磁性薄膜存储单元 MFC2 直接相连，同时与磁性薄膜存储单元 MFC2 的易磁化方向相互垂直。

如图 3 所示，整个 MRAM 单元 1 由若干层 5a、5b、5c、5d、5e 构成，  
5 这些层中的非功能区域由绝缘掩埋介质填埋。在 MRAM 单元 1 中金属布线层仅有两层 5b、5d，即位线 BL 3a 所在层 5d 及地线 GND 3c、过渡金属层 3b 所在层 5b。磁性薄膜存储单元 MFC2 布置在位线 BL 3a 的下方且其上部电极与位线 BL 3a 直接相连接；磁性薄膜存储单元 MFC2 的下部电极通过过渡金属层 3b、接触孔 3f 与晶体管 ATR 4 的漏极 4c 相连接。磁性薄膜存储单元  
10 MFC2 中的自由层的易磁化轴与位线 BL 3a 的长边方向相互垂直。

为了使写入操作过程中位线 BL 3a 上的电流能够有适当大小的一部分电流分流至由磁性薄膜存储单元 MFC2 到地线 GND 3c 的通路上，需要在 MRAM 阵列中的每一条位线 BL 上设置一个或几个限流机构，如图 4 所示为设置一个限流机构的示意图。这样，当位线 BL 上的电流小于限流机构的限  
15 定电流，即  $I \leq I_s$ ，几乎全部的电流都从位线 BL 通过而没有流经磁性薄膜存储单元 MFC 的分流。 $I_s$  的具体大小由磁性薄膜存储单元 MFC 的磁化翻转特性参数来确定，并且使大小为  $I_s$  的电流产生的磁场不能导致磁性薄膜存储单元 MFC 的磁化翻转。当  $I > I_s$  时，在限流机构的作用下使  $I_1 = I_s$  且  $I_1 + I_2 = I$ ，这时就存在两个互相垂直的电流  $I_1$  和  $I_2$ ，前者与磁性薄膜存储单元 MFC 的表面平行，而后者与磁性薄膜存储单元 MFC 的表面垂直。由这电流  $I_1$  和  $I_2$  产生的磁性薄膜存储单元 MFC 自由层处的磁场如图 5 所示 ( $I_2$  的分布以点电流分布为例)。由电流  $I_1$  产生的磁场在磁性薄膜存储单元 MFC 的易磁化轴方向上，而由电流  $I_2$  产生的磁场则是磁性薄膜存储单元 MFC 自由层面内的环形磁场，  
20 由背景技术部分的论述可知，在这样的合成磁场作用下，可以实现磁性薄膜存储单元 MFC 的磁化翻转，即 MRAM 中信息的写入。这时  $I_2 = I - I_1 = I - I_s$ ，它的大小也由磁性薄膜存储单元 MFC 的磁化翻转特性参数来确定，并且使大小为  $I_2$  和  $I_s$  的电流产生的合成磁场能够导致磁性薄膜存储单元 MFC 的磁化翻转。对于 MRAM 阵列外部的驱动电流而言，本实施例的 MRAM 的写入电  
25 流只有一个，即  $I = I_s + I_2$ 。

由此，以图 2、图 3 所示单元为例，在 MRAM 的寻址读出操作中，首先  
30 是被选择的字线 WL 3d 给一个适当的电平以使晶体管 ATR 4 处于导通状态，

然后是被选择的位线 BL 3a 上导入一个读出电流，则读出电流由位线 BL 3a 经磁性薄膜存储单元 MFC2、过渡金属层 3b、接触孔 3f、晶体管 ATR 漏极 4c、晶体管 ATR 源极 4a、接触孔 3e 而达地线 GND 3c，从而获取磁性薄膜存储单元 MFC2 当前的电阻状态，即 MRAM 单元 1 中所存储的数据；在 MRAM 的寻址写入操作中，首先也是被选择的字线 WL 3d 给一个适当的电平以使晶体管 ATR 4 处于导通状态，然后在位线 BL 3a 上导入写入电流。在限流机构的作用下该写入电流被分成平行于被选择磁性薄膜存储单元 MFC2 的分流  $I_1$  和垂直于被选择磁性薄膜存储单元 MFC2、并且流经被选择磁性薄膜存储单元 MFC2 到 GND 3c 的分流  $I_2$ ，它们产生的合成磁场将导致磁性薄膜存储单元 MFC 的磁化翻转，也即完成了数据的写入。

位线 BL 上的限流机构可以设置并集成在 MRAM 阵列的外围电路中，它可具有单向限流的功能，由二极管、三极管等构成。

#### 实施例 2：

如图 6、图 7 所示，在一个 MRAM 单元 1 中，包括一个磁性薄膜存储单元 MFC2、晶体管 ATR 4、过渡金属层 3b、接触孔 3e 与 3f 和一组布线，即位线 BL1 3a、位线 BL2 3g、字线 WL 3d 以及地线 GND 3c。磁性薄膜存储单元 MFC2 与晶体管 ATR 4 通过过渡金属层 3b 相互连接。在布局上，将位线 BL1 3a、BL2 3g 布置在磁性薄膜存储单元 MFC2 的上方并且位线 BL2 3g 与存储单元 2 直接相连，同时与单元 2 的易磁化轴相互垂直；位线 BL1 3a 与 BL2 3g 由绝缘层 5e 隔离，并且两者彼此平行。

如图 7 所示，整个 MRAM 单元 1 由若干层 5a、5b、5c、5d、5e、5f、5g、构成，这些层中的非功能区域由绝缘掩埋介质填埋。在 MRAM 单元 1 中金属布线层有三层 5b、5d 和 5f，即位线 BL1 3a 所在层 5f、位线 BL2 3g 所在层 5d 及地线 GND 3c、过渡金属层 3b 所在层 5b。磁性薄膜存储单元 MFC2 布置在位线 BL1 3a、BL2 3g 的下方且其上部电极与位线 BL2 3g 直接相连接；磁性薄膜存储单元 MFC2 的下部电极通过过渡金属层 3b、接触孔 3f 与晶体管 ATR 4 的漏极 4c 相连接。磁性薄膜存储单元 MFC2 中的自由层的易磁化方向与位线 BL1 3a、BL2 3g 的长边方向相互垂直，位线 BL1 3a 与 BL2 3g 相互平行。

在本实施例的寻址读出操作中，首先是被选择的字线 WL 3d 给一个适当的电平以使晶体管 ATR 4 处于导通状态，然后是被选择的位线 BL2 3g 上导入

一个读出电流，则读出电流由位线 BL2 3g 经磁性薄膜存储单元 MFC2、过渡金属层 3b、接触孔 3f、晶体管 ATR 漏极 4c、晶体管 ATR 源极 4a、接触孔 3e 而达地线 GND 3c，从而获取磁性薄膜存储单元 MFC2 当前的电阻状态，即 MRAM 单元 1 中所存储的数据；在寻址写入操作中，首先也是被选择的字线 5 WL 3d 给一个适当的电平以使晶体管 ATR 4 处于导通状态，然后在位线 BL1 3a、BL2 3g 上以一定的时序关系导入各自的写入电流。位线 BL1 3a 上的电流平行于被选择磁性薄膜存储单元 MFC2，位线 BL2 3g 上的电流将流经被选择磁性薄膜存储单元 MFC2 而到达 GND 3c，它们产生的合成磁场将导致磁性薄膜存储单元 MFC2 的磁化翻转，也即完成了数据的写入。

10 实施例 2 之变形例：

如图 8、图 9 所示，本变形例将实施例 2 中的位线 BL2 3g 的方向从与位线 BL1 3a 平行改为与字线 WL 3d 平行。本例中以字线 WL2 来命名，同时将原来的字线改为 WL1 以示区别。其它部分的结构都与实施例 2 中所述基本一致，这里不再赘述。

15 在本变形例的寻址读出操作中，首先是被选择的字线 WL1 3d 给一个适当的电平以使晶体管 ATR 4 处于导通状态，然后是被选择的字线 WL2 3g 上导入一个读出电流，则读出电流由字线 WL2 3g 经磁性薄膜存储单元 MFC2、过渡金属层 3b、接触孔 3f、晶体管 ATR 漏极 4c、晶体管 ATR 源极 4a、接触孔 20 3e 而达地线 GND 3c，从而获取磁性薄膜存储单元 MFC2 当前的电阻状态，即 MRAM 单元 1 中所存储的数据；在寻址写入操作中，首先也是被选择的字线 WL1 3d 给一个适当的电平以使晶体管 ATR 4 处于导通状态，然后在位线 BL 3a、字线 WL2 3g 上以一定的时序关系导入各自的写入电流。位线 BL 3a 上的电流平行于被选择磁性薄膜存储单元 MFC2，字线 WL2 3g 上的电流将流经被选择磁性薄膜存储单元 MFC2 而到达 GND 3c，它们产生的合成 25 磁场将导致磁性薄膜存储单元 MFC2 的磁化翻转，也即完成了数据的写入。

## 权利要求书

1、一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器的控制方法，其特征在于，  
磁随机存取存储器磁性薄膜存储单元 MFC 中的信息写入操作由一个平行于磁  
5 性薄膜存储单元 MFC 的电流以及另一个垂直于磁性薄膜存储单元 MFC、并流  
经该单元的电流所产生的磁场的共同作用来完成。

2、一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，包括：

a) 晶体管 ATR (4) 单元构成的存储器控制单元阵列，该控制单元阵列集成在半导体衬底中；

10 b) 磁性薄膜存储单元 MFC (2) 构成的存储单元阵列；

c) 接触孔 (3e、3f) 与过渡金属层，所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 经由接触孔 (3f) 与过渡金属层和所述晶体管 ATR (4) 单元相连接；

d) 字线 WL (3d) 和位线 BL (3a)；

15 其特征在于：所述位线 BL (3a) 布置在所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的上方、与之直接相连接并且与磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的易磁化方向垂直。

3、按照权利要求 2 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，设置有限流机构，该限流机构可由二极管、三极管等构成；一个或多个限流机构与每一条位线 BL 连接设置在 MRAM 阵列的外围电路中。

20 4、按照权利要求 3 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的基本结构由两层磁性材料层以及介于两磁层之间的非磁性材料层构成，存储信息由其中一个磁性材料层的磁化状态来表示并保存。

25 5、按照权利要求 4 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述位线 BL (3a) 和所述字线 WL (3d) 相互垂直，所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的易磁化方向与所述位线 BL (3a) 相互垂直。

6、按照权利要求 5 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述字线 WL (3d) 同时作为所述晶体管 ATR (4) 单元的栅极。

30 7、按照权利要求 6 中所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，在读出信息的过程中，所述晶体管 ATR (4) 导通，读出电流由所述 BL (3a) 引入来获取所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 中存储的信息。

8、按照权利要求 2 至 7 任一所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，内部金属布线层总共为两层，即所述位线 BL (3a) 所在层 (5d) 和所述过渡金属层 (3b) 与地线 GND (3c) 所在层 (5b)。

9、一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，包括：

5 a) 晶体管 ATR (4) 单元构成的存储器读写控制单元阵列，该读写控制单元集成在半导体衬底中；

b) 磁性薄膜存储单元 MFC (2) 构成的存储单元阵列；

c) 接触孔 (3e、3f)；

d) 字线 WL (3d) 和两条位线 BL1 (3a)、BL2 (3g)；

10 其特征在于：还包括过度金属层 (3b)，所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 经由该过渡金属层 (3b) 和所述接触孔 (3f) 与所述晶体管 ATR (4) 单元相连接；所述 BL1 (3a) 和 BL2 (3g) 由绝缘介质隔离、在方向上相互平行，同时所述位线 BL2 (3g) 与所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 直接相连接。

15 10、按照权利要求 9 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的基本结构由两层磁性材料层以及介于两磁层之间的非磁性材料层构成，存储信息由其中一个磁性材料层的磁化状态来表示并保存。

20 11、按照权利要求 10 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述位线 BL1 (3a) 和 BL2 (3g) 的方向与所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的易磁化方向垂直，且与所述字线 WL (3d) 的方向相互垂直。

12、按照权利要求 11 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述字线 WL (3d) 同时作为所述晶体管 ATR (4) 单元的栅极。

25 13、按照权利要求 12 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，在读出信息的过程中，所述晶体管 ATR (4) 导通，读出电流由所述位线 BL2 (3g) 引入来获取所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 中存储的信息。

30 14、按照权利要求 13 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，其写入操作过程由所述位线 BL1 (3a) 上平行于所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的电流与所述位线 BL2 (3g) 引入的、垂直于磁性薄膜存储单元 MFC (2)、并流经所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的电流的共同作用来完成。

15、按照权利要求 9 至 14 任一所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，内部金属布线层总共为三层，即所述位线 BL (3a) 所在层、所述位线 BL (3g) 所在层以及地线 GND (3c) 与过渡金属层 (3b) 所在层。

5 16、一种基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，包括：

a) 晶体管 ATR (4) 单元构成的存储器读写控制单元阵列，该读写控制单元阵列集成在半导体衬底中；

b) 磁性薄膜存储单元 MFC (2) 构成的存储单元阵列；

c) 接触孔 (3e、3f)；

10 d) 两条字线 WL1 (3d)、WL2 (3g) 和位线 BL (3a)；

其特征在于：所述字线 WL2 (3g) 与所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 直接相连接并与所述位线 BL (3a) 相互垂直。

15 17、按照权利要求 16 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的基本结构由两层磁性材料层以及介于两磁层之间的非磁性材料层构成，存储信息由其中一个磁性材料层的磁化状态来表示并保存。

18、按照权利要求 17 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述位线 BL (3a) 和所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的易磁化方向垂直，且与所述位线 WL1 (3d)、WL2 (3g) 相互垂直。

20 19、按照权利要求 18 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，所述位线 BL (3a) 布置在所述字线 WL2 (3g) 的上方且与之绝缘隔离。

20、按照权利要求 19 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于所述字线 WL (3d) 同时作为所述晶体管 ATR (4) 单元的栅极。

25 21、按照权利要求 20 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，在读出信息的过程中，所述晶体管 ATR (4) 导通，读出电流由所述字线 WL2 (3g) 引入来获取所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 中存储的信息。

22、按照权利要求 21 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，还包括过渡金属层 (3b)，所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 经由该过渡金属层 (3b) 和所述接触孔 (3f) 与所述晶体管 ATR (4) 单元相连接。

23、按照权利要求 22 所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，其写入操作过程由所述位线 BL (3a) 上平行于所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的电流与从所述字线 WL2 (3g) 引入的、垂直于磁性薄膜存储单元 MFC (2)、并流经所述磁性薄膜存储单元 MFC (2) 的电流的共同作用来完成。

24、按照权利要求 16 至 23 任一所述的基于垂直电流写入的磁随机存取存储器，其特征在于，内部金属布线层总共为三层，即所述位线 BL (3a) 所在层、所述字线 WL2 (3g) 所在层，以及地线 GND (3c) 与所述过渡金属层 (3b) 所在层。

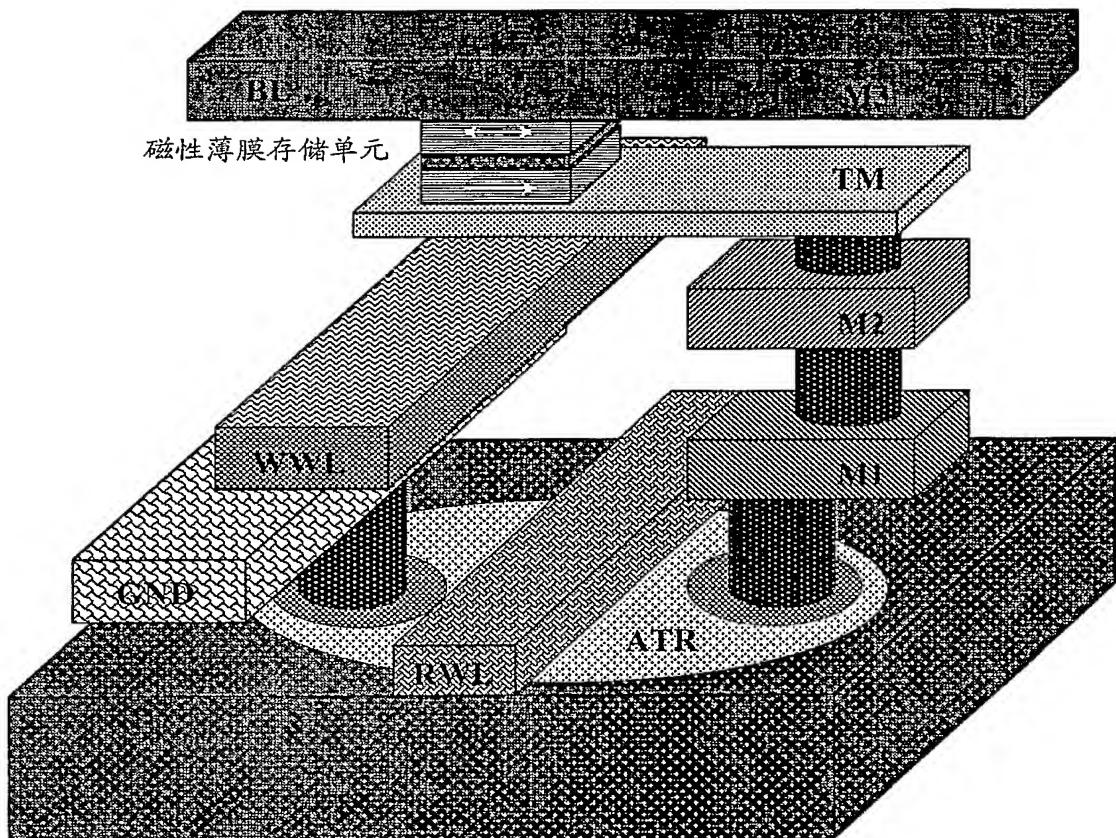


Fig.1 (现有技术)

2/5

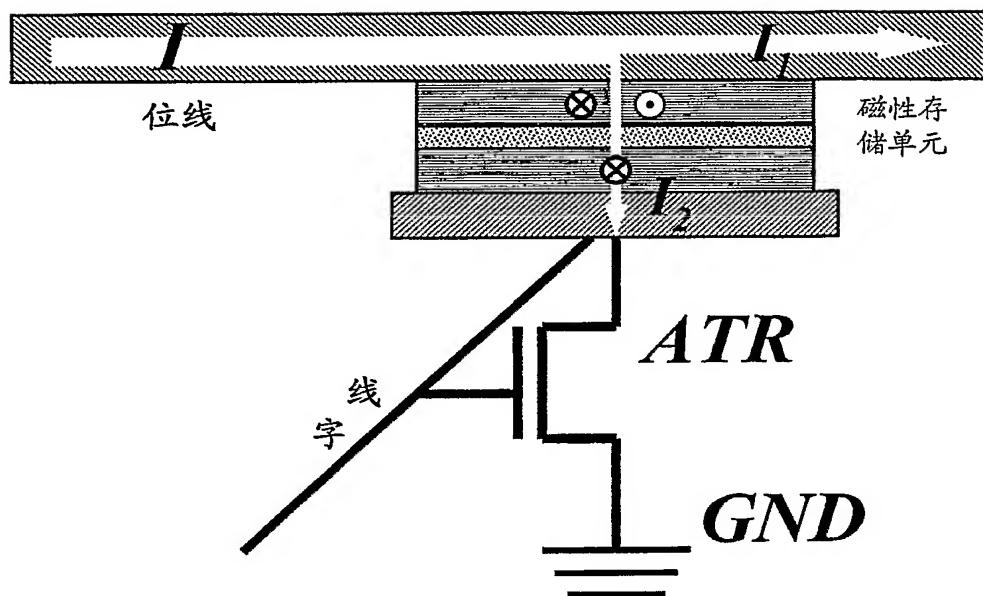


Fig.2

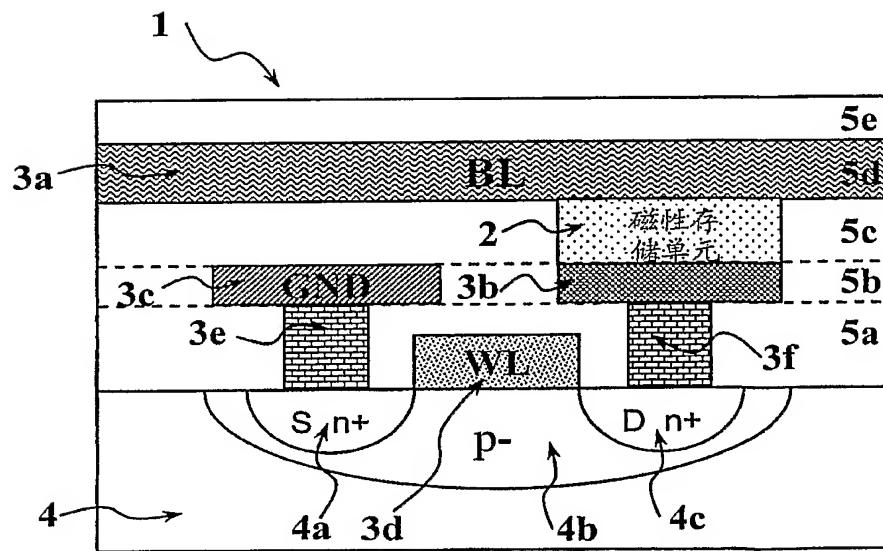


Fig.3

3/5

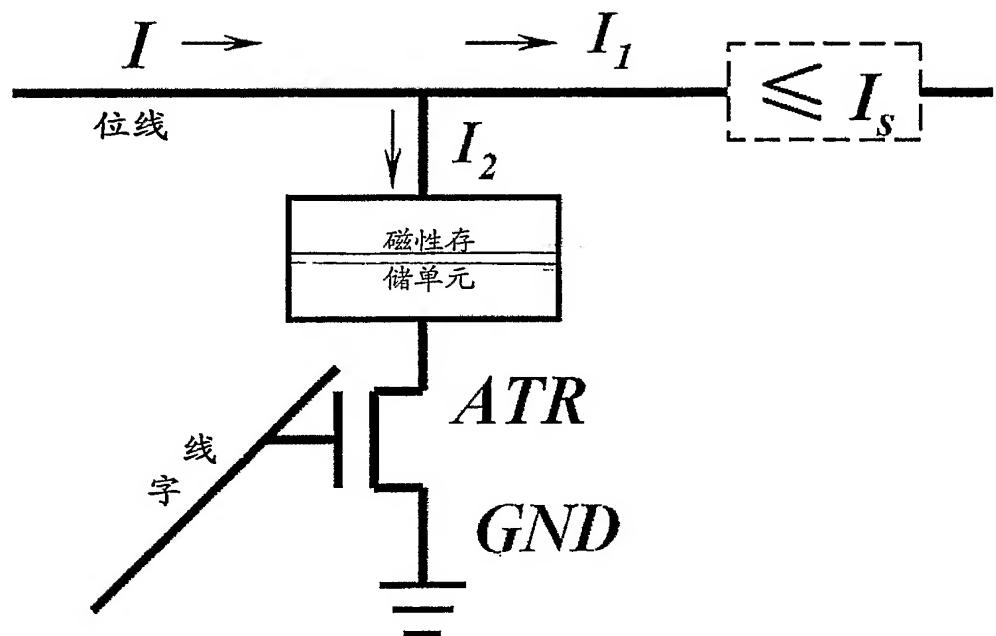


Fig.4

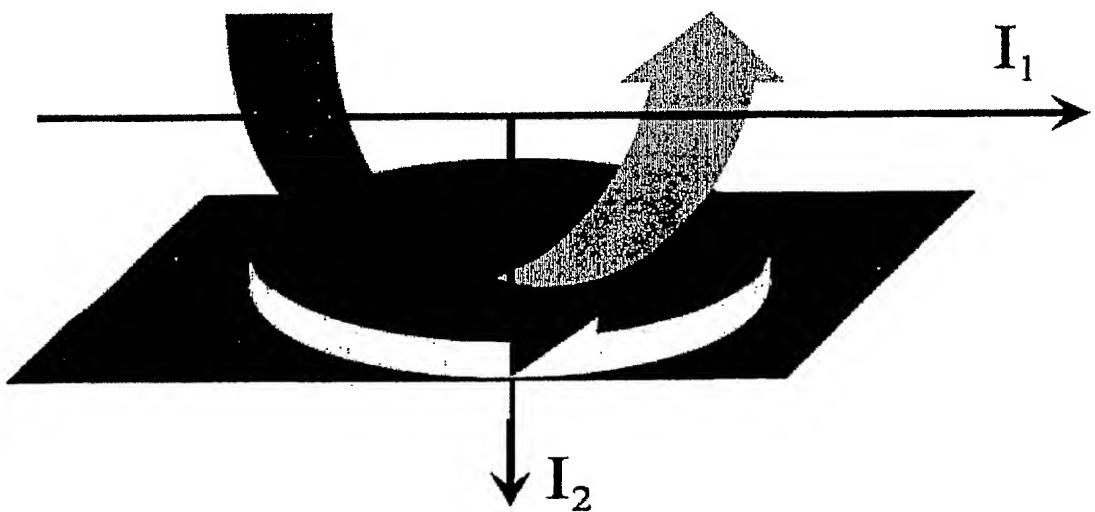


Fig.5

4/5

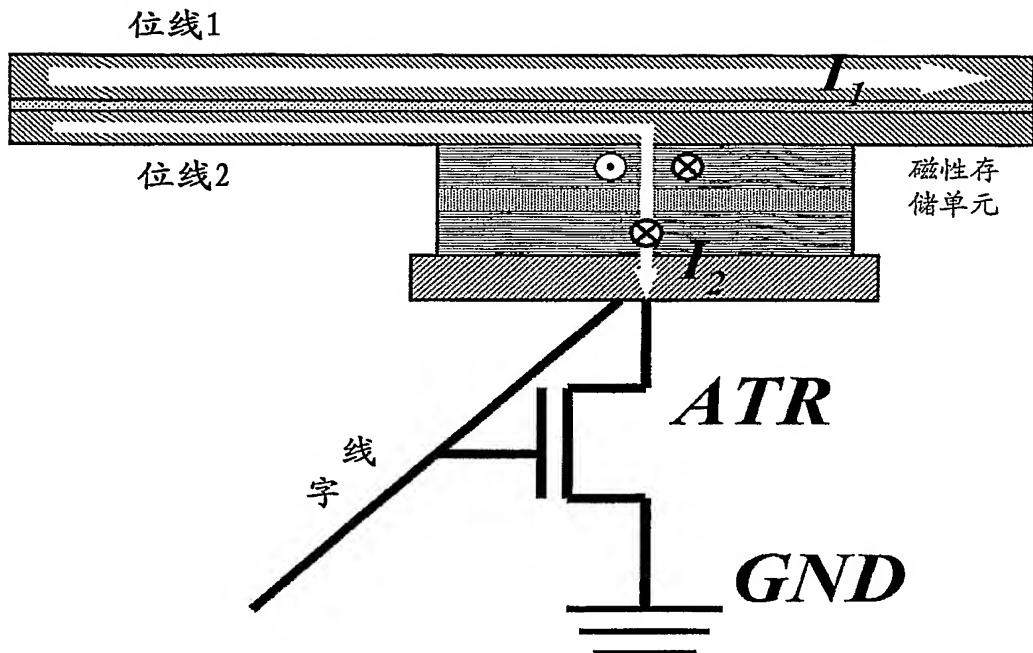


Fig.6

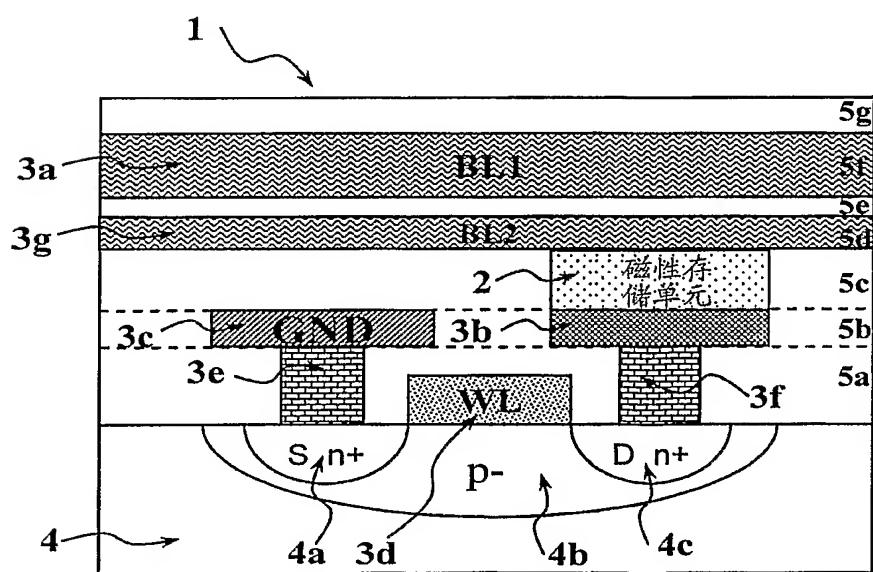


Fig.7

5/5

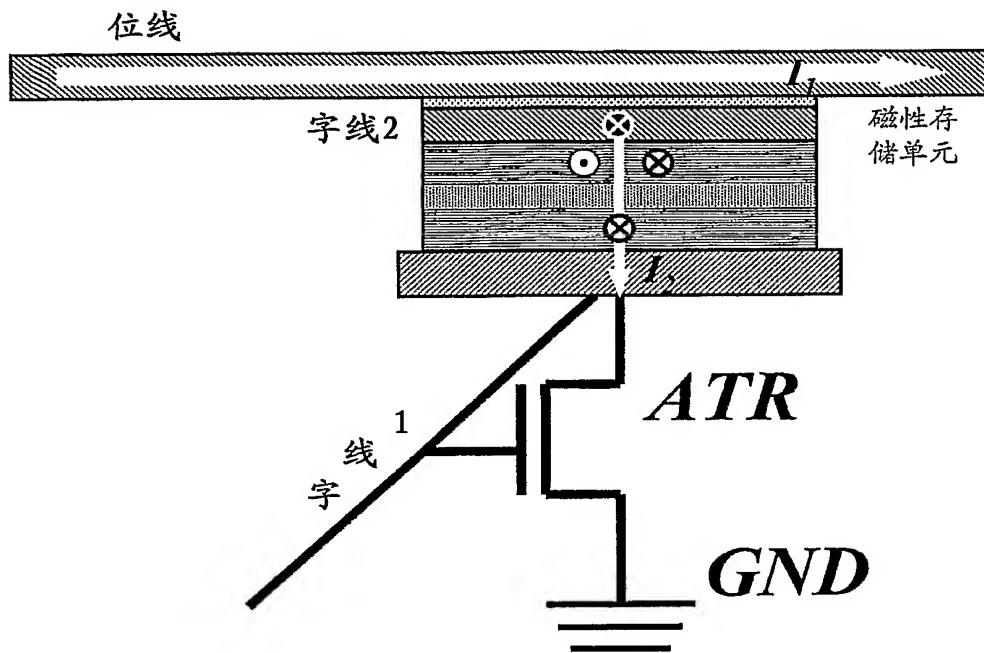


Fig.8

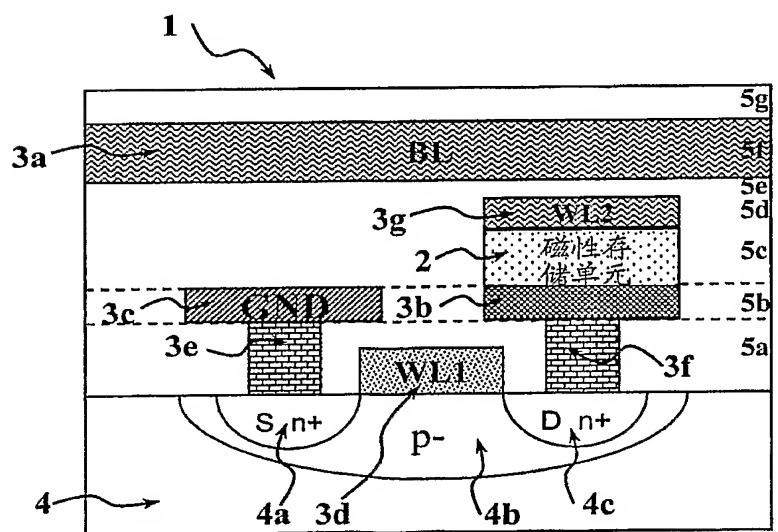


Fig.9

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/CN2004/001385

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC<sup>7</sup> G11C11/14 H01L27/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC<sup>7</sup> G11C H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI PAJ EPODOC PATENTPIC CNPAT ( magnetic MRAM writ+ vertical RAM current )

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  A CN1385905A(HYNIX SEMICONDUCTOR INC)18.Dec 2002 (18.12.2002) see the whole document  A CN1433022A(SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD)30.Jul2003 (30.07.2003) see the whole document  A US2004/0052127A1 (NEC CORP) 18.Mar.2004 (18.03.2004) see the whole document	Relevant to claim No.  1-24  1-24  1-24

Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

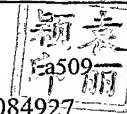
Date of the actual completion of the international search  
28.Feb2005 (28.02.2005)

Date of mailing of the international search report

17 · MAR 2005 (17.03.2005)

Name and mailing address of the ISA/  
6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District,  
100088 Beijing, China  
Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer



Telephone No. (86-10)62084927

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
Information on patent family members

International application No.  
PCT/CN2004/001385

CN1385905A	18.12.2002	US6649953 B2 KR399436 B JP2002329846 A	18.11.2003 29.09.2003 15.11.2002
CN1433022A	30.07.2003	KR2003060327 A US2003128580 A1 EP1329895 A2 JP2003218328 A	16.07.2003 10.07.2003 23.07.2003 31.07.2003
US2004/0052127A1	18.03.2004	JP2004104027A JP2004119904 A	02.04.2004 15.04.2004

**A. 主题的分类**

IPC 第 7 版 G11C11/14 H01L27/00

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

**B. 检索领域**

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC 第 7 版 G11C H01L

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

数据库: CNPAT WPI EPODOC PATENTPIC PAJ

检索词: 磁 随机存储器 MRAM 写 垂直 RAM 电流

magnetic MRAM writ+ vertical RAM current

**C. 相关文件**

类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
A	CN1385905A(海力士半导体有限公司)18.12月 2002 (18.12.2002) 全文	1-24
A	CN1433022A(三星电子株式会社)30.7月.2003 (30.07.2003) 全文	1-24
A	US2004/0052127A1 (NEC 公司) 18.3月.2004 (18.03.2004) 全文	1-24

 其余文件在 C 栏的续页中列出。 见同族专利附件。

## \* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&amp;” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

28.2月 2005 (28.02.2005)

国际检索报告邮寄日期

17·3月 2005 (17·03·2005)

中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10)62019451

受权官员



电话号码: (86-10)62084927

国际检索报告  
关于同族专利的信息

国际申请号  
PCT/CN2004/001385

检索报告中引用的专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN1385905A	18.12.2002	US6649953 B2	18.11.2003
		KR399436 B	29.09.2003
		JP2002329846 A	15.11.2002
CN1433022A	30.07.2003	KR2003060327 A	16.07.2003
		US2003128580 A1	10.07.2003
		EP1329895 A2	23.07.2003
US2004/0052127A1	18.03.2004	JP2003218328 A	31.07.2003
		JP2004104027A	02.04.2004
		JP2004119904 A	15.04.2004